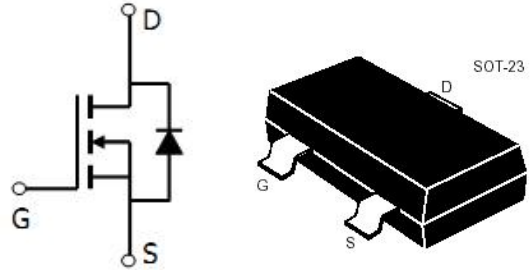




GM5198

SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



**N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs**

N 溝道增強型 MOS 場效應管

■ **MAXIMUM RATINGS 最大額定值**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rat 額定值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$BV_{DSS}$	60	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Drain Current-continuous 漏極電流-連續	$I_{DR}$	2.2	A
Drain Current-pulsed 漏極電流-脈沖	$I_{DRM}$	27	A

■ **THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性**

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$	$P_D$	900	mW
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	139	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	$150^\circ\text{C}, -55\text{to}+150^\circ\text{C}$	

GM5198

■DEVICE MARKING 打標

GM5198=AA6

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$BV_{DSS}$	60	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$ )	$V_{GS(th)}$	1	—	2.5	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_{SD}=1\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$V_{SD}$	—	—	1.2	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=60\text{V}$ )	$I_{DSS}$	—	—	1	$\mu\text{A}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=1\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ ) ( $I_D=1\text{A}, V_{GS}=4.5\text{V}$ )	$R_{DS(on)}$	—	—	155 205	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	—	250	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	—	25	pF
Reverse Transfer Capacitance 回饋電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{RSS}$	—	—	16	pF
Turn-ON Time 開啓時間 ( $V_{DS}=30\text{V}, I_D=1\text{A}, R_{GEN}=10\Omega$ )	$t_{(on)}$	—	—	10	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ( $V_{DS}=30\text{V}, I_D=1\text{A}, R_{GEN}=10\Omega$ )	$t_{(off)}$	—	—	30	ns

Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$ ; Duty Cycle $\leq 2.0\%$ .